







	<h2>SI7742DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7742DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7742DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1900 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7742DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1900 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 60A (Tc) 5.4W (Ta), 83W (Tc) Surface
Serie	SkyFET®, TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	115nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5300pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7742DP-T1-GE3TR

SI7742DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7742DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7742DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7742DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7748DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7742DP SI SI7742DP SI</p>	 <p>SI7738DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7748DP VISHAY VISHAY QFN</p>
 <p>SI7758DP VB SI7758DP VB</p>	 <p>SI7742DP-T1-E3 VISHAY SI7742DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7738DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7748DP-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN</p>

heiße Teile

Mehr

SI7703EDN-TI-E3	SI7705DN	SI7705DN-T1	SI7705DN-T1-E3	SI7716ADN
SI7716ADN-T1-E3	SI7716ADN-T1-GE3	SI7716ADN-T1-GE3	SI7716ADN-TI-GE3	SI7716DN-T1-GE3
SI7720DN-T1-E3	SI7720DN-T1-GE3	SI7720DN-T1-GE3	SI7726DN	SI7726DN-T1-E3
SI7726DN-T1-GE3	SI7726DN-T1-GE3	SI7732DP-T1-GE3	SI7738DP	SI7738DP-T1-3
SI7738DP-T1-E3	SI7738DP-T1-E3	SI7738DP-T1-GE3	SI7738DP-T1-GE3	SI7742DP-T1-E3
SI7742DP-T1-GE3	SI7748DP-T1-GE3	SI7748DP-T1-GE3	SI7758DP	SI7758DP-T1-GE3
SI7758DP-T1-GE3	SI7772DP-T1-GE3	SI7772DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3
SI7784DP-T1-GE3	SI7784DP-T1-GE3	SI7788DP-T1-GE3	SI7788DP-T1-GE3	SI7790DP-T1-E3
SI7790DP-T1-GE3	SI7790DP-T1-GE3	SI7792DP-T1-GE3	SI7792DP-T1-GE3	SI7794DP-T1-GE3
SI7794DP-T1-GE3	SI7798DP-T1-GE3	SI7804DN	SI7804DN-T1-E3	SI7804DN-T1-E3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited